









 	<h2 style="color: red;">FQD7N20TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7N20TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD7N20TM.pdf  2.FQD7N20TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5708 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5708 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD7N20TM ist neu im Original, Suche FQD7N20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N30TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>
 <p>FQD7N30 FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD7N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p>FQD7N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD6N50CTM	 FQD6N50CTM	 FQD6N60C	 FQD6N60CS	 FQD6N60CTF
 FQD6N60CTM	 FQD6N60CTM	 FQD6P25TM	 FQD6P25TM	 FQD7N10L
 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM	 FQD7N10TF
 FQD7N10TM	 FQD7N10TM	 FQD7N20L	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTF
 FQD7N20LTM	 FQD7N20LTM	 FQD7N20TF	 FQD7N20TF	 FQD7N20TM
 FQD7N30TM	 FQD7N30TM	 FQD7P06TF	 FQD7P06TF	 FQD7P06TM
 FQD7P06TM	 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_NB82050	 FQD7P06TM_NB82050
 FQD7P10TF	 FQD7P20TF	 FQD7P20TF	 FQD7P20TM	 FQD7P20TM
 FQD7P20TM_F080	 FQD7P20TM_F080	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF_NB82052
 FQD8P10TF_NB82052	 FQD8P10TM	 FQD8P10TM	 FQD8P10TM_	 FQD8P10TM_F080

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited